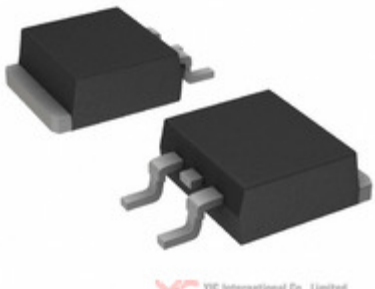

	<h2 style="color: red;">FDB16AN08A0</h2>
 <p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	Hersteller-Teilenummer: FDB16AN08A0
	Hersteller / Marke: AMI Semiconductor / ON Semiconductor
	Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 75V 58A TO-263AB
	Datenblätter:  FDB16AN08A0.pdf
	RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform
	Lagerzustand: New original, 32790 pcs Stock Available.
	Liefern von: Hong Kong
Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	


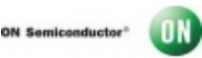
Spezifikationen

Teilenummer	FDB16AN08A0
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 75V 58A TO-263AB
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	32790 pcs Stock
VGS (th) (Max) @ Id	4V @ 250µA
Vgs (Max)	±20V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	D ² PAK
Serie	PowerTrench®
Rds On (Max) @ Id, Vgs	16 mOhm @ 58A, 10V
Verlustleistung (max)	135W (Tc)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	TO-263-3, D ² Pak (2 Leads + Tab), TO-263AB
Andere Namen	FDB16AN08A0-ND
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Hersteller Standard Vorlaufzeit	6 Weeks
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	1857pF @ 25V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	42nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	6V, 10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	75V
detaillierte Beschreibung	N-Channel 75V 9A (Ta), 58A (Tc) 135W (Tc) Surface
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	9A (Ta), 58A (Tc)

FDB16AN08A0 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, FDB16AN08A0-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, FDB16AN08A0 AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ FDB16AN08A0 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>FDB15N50 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 500V 15A TO-263AB</p>	 <p>FDB16AN08A0 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 75V 58A TO-263AB</p>	 <p>FDB20AN06A0 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 60V 45A TO-263AB</p>	 <p>FDB19N20CTM FAI FAI SO-263</p>
 <p>FDB1D7N10CL7 AMI Semiconductor / ON Semiconductor FET 100V 1.7 MOHM D2PAK</p>	 <p>FDB16AN08A0 FAIRCHI FDB16AN08A0 FAIRCHI</p>	 <p>FDB20AN06A0 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 60V 45A TO-263AB</p>	 <p>FDB15N50 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 500V 15A TO-263AB</p>

FDB16AN08A0 Zugehöriges

Mehr

Schlüsselwort

AMI Semiconductor / ON Semiconductor	FDB16AN08A0 Datenblatt	FDB16AN08A0-Datenblätter	FDB16AN08A0 PDF	AMI Semiconductor / ON Semiconductor FDB16AN08A0
FDB16AN08A0 Electronic	FDB16AN08A0-Komponenten	FDB16AN08A0-Verteiler	FDB16AN08A0-Bild	FDB16AN08A0-Teil
FDB16AN08A0 Preis	FDB16AN08A0 Hersteller	FDB16AN08A0 Bild	FDB16AN08A0 Aktie	FDB16AN08A0 Inventar
FDB16AN08A0 Neu	FDB16AN08A0 Original	FDB16AN08A0 garantiert	FDB16AN08A0 RFQ	FDB16AN08A0 Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr. 509, 5 / F Sing Win-Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip Street, Kwun Tong, Kowloon, Hongkong.

Copyright © 2020 YIC International Co., Limited